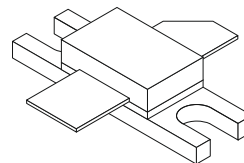


Мощный СВЧ GaN транзистор с напряжением питания 28 В
 Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-55С-1
 Предназначен для работы в усилителях мощности до 3500 МГц



- Выходная мощность $P_{\text{вых}} = 50$ Вт
- Напряжение питания $U_{\text{си}} = 28$ В
- Коэффициент усиления по мощности $K_{\text{ур}} \geq 11$ дБ
- КПД стока $\eta_c \geq 60$ %

Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Максимально допустимый ток стока	I_c макс	6	А
Максимально допустимый прямой ток затвора	I_z (пр) макс	15	мА
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	$U_{\text{си макс}}$	80*	В
Напряжение затвор-исток	$U_{\text{зи}}$	-10 до +2	В
Максимально допустимая температура перехода	$t_{\text{п макс}}$	225	°С
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	°С
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора	$R_{\text{т п-к}}$	**	°С/Вт

* Для всего диапазона рабочих температур

** Уточняется в ходе проведения испытаний

Электрические параметры транзисторов

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), °С
Остаточный ток стока	I_c ост	$U_{\text{си}}=80$ В; $U_{\text{зи}}=-8$ В	-	-	4	мА	25±10
Крутизна характеристики	S	$I_c=3.2$ А; $U_{\text{си}}=10$ В	2,8	3,5	-	А/В	25±10
Ток стока	I_c	$U_{\text{си}}=6$ В; $U_{\text{зи}}=2$ В	12,5	15,0	-	А	25±10
Выходная мощность	$P_{\text{вых}}$	$f=2900$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=5$ Вт; $I_c=0,1$ А	50	65	-	Вт	25±15
Коэффициент усиления по мощности	$K_{\text{ур}}$	$f=2900$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=50$ Вт; $I_c=0,1$ А	11	11,5	-	дБ	25±15
КПД стока	η_c	$f=2900$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=50$ Вт; $I_c=0,1$ А	60	65	-	%	25±15

Габаритный чертеж

